(11)特許番号

						特許	午第4477567号
(45)発行日	平成225	≢6月9日(2010.6.9))		(24) 登録日	平成22年3月]	(94477367)
(51) Int.Cl.			FI				
G02F	1/313	(2006.01)	GO2F	1/313			
GO2F	1/295	(2006.01)	GO2F	1/295			
GO2F	1/025	(2006.01)	GO2F	1/025			
HO1S	5/14	(2006.01)	HO1S	5/14			
HO1S	5/50	(2006.01)	HO1S	5/50	630		
						請求項の数	4 (全 21 頁)
(21) 出願番号	}	特願2005-304711(P2005-304711)	(73)特許	権者 59618007	6	
(22) 出願日		平成17年10月19日	(2005.10.19)		韓國電子通	信研究院	
(65) 公開番号		特開2006-171706 (P2006-171706A)			Elect	ronics	and Tel
(43) 公開日		平成18年6月29日 (2006.6.29)			ecomm	unicati	ons Res
審査請求日		平成17年10月19日 (2005.10.19)			earch	lnstit	ute
(31) 優先権主張番号		10-2004-0105679			大韓民国大	田廣域市儒城區	柯亭洞161
(32) 優先日		平成16年12月14日	(2004.12.14)		161 K	a j o n g – d	ong, Yu
(33)優先権主張国		韓国(KR)			song-	gu, Tae	jon kor
					еa		
前置審査				(74)代理	人 100077481		
					弁理士 谷	義一	
				(74)代理	人 100088915		
					弁理士 阿	部 和夫	
				(74)復代	理人 10011562	4	
					弁理士 濱	中淳宏	
						;	最終頁に続く

(12) 特許公報(B2)

(54) 【発明の名称】光偏向器を備えた波長可変逆多重化器および波長可変レーザ

(57)【特許請求の範囲】

(19) 日本国特許庁(JP)

【請求項1】

お互い異なる波長の光が導波される入力導波路と、

第1の有効屈折率を有する周辺領域と、前記第1の有効屈折率とは異なる第2の有効屈 折率を持つ所定形状の偏向パターン領域とが境界を成して構成された入力結合器であって 、前記境界において前記第1の有効屈折率と前記第2の有効屈折率との屈折率の差に基づ き光を屈折することにより、前記入力導波路を介して入力され、前記入力導波路と入力結 合器の接続点を出発点として放射状に分散する光を偏向させる入力結合器と、

前記入力結合器を介して伝達された光が通過するアレイ導波路と、

前記アレイ導波路から出力された光が結合する出力結合器とを備え、

前記所定形状の偏向パターン領域の境界を形成する軌跡 y = f (x)は、放射状に分散 する光の仮想的な出発点の位置が、前記第2の有効屈折率の変化に伴って、ローランド円 上を移動するように設計され、

前記第2の有効屈折率の変化に応じて前記出力結合器に結合される複数の出力導波路の 各々に結像される波長を可変とし、前記アレイ導波路は、隣接する導波路間の光路長が互 いに異なる複数の導波路からなることを特徴とする波長可変逆多重化器。

【請求項2】

第1断面および第2断面を両端部に備える光増幅器と、

前記光増幅器に集積され、前記第1断面から放射されて出射されるビームを凹回折格子 に伝達し、凹回折格子から反射されたビームを、前記第1断面より光増幅器に帰還させて

10

、光反射面である前記第2断面で受けることにより、前記第2断面と凹回折格子との間で ビームを共振させる前記光増幅器および前記凹回折格子との間に位置する光偏向器であっ て、第1有効屈折率を有する周辺領域と、

前記第1有効屈折率とは異なる第2有効屈折率を有する所定の形状の偏向パターン領域 とが境界をなし、前記境界において前記第1有効屈折率と前記第2有効屈折率との屈折率 の差に基づき光を屈折する光偏向器と、

前記光偏向器に連結され、前記光偏向器から入射したビームの中でも特定の波長のみを 前記光増幅器に帰還させる凹回折格子とを備え、

前記光偏向器の前記所定の形状の偏向パターン領域の境界を形成する軌跡 y = f (x) は、前記光増幅器の前記第1断面から放射状に分散する光の仮想的な出発点の位置が、前 記第2有効屈折率の変化に伴って、ローランド円上を移動<u>するように設計され</u>、前記第2 有効屈折率の変化に伴い、前記光偏向器により偏向された光の凹回折格子への入射角が変 わることにより、前記光増幅器に帰還される波長を変化させることを特徴とする波長可変 レーザ。

【請求項3】

前記光偏向器は、下部クラッド層、上部クラッド層およびコア層を含むことを特徴とす る請求項2に記載の波長可変レーザ。

【請求項4】

前記周辺領域と前記所定の形状の偏向パターン領域は、各領域のコア層に印加される電 流差によって区分されることを特徴とする請求項3に記載の波長可変レーザ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【 0 0 0 1 】

本発明は、波長可変逆多重化器および波長可変レーザに関し、より詳しくは、所定の形 状の偏向パターン領域と周辺領域は上部クラッド層のドーピング構造の差により境界を成 して構成されるが、外部電気信号の調節によって、偏向パターン領域内のコア層の屈折率 が変化し、放射状に分散する光を偏向させる光偏向器を備える光素子に関する。

【背景技術】

[0002]

まず、波長可変逆多重化器について説明する。

光通信システムにおいて、様々な波長のビームを一つの位置に集束させる機能(多重化)、任意のビームを波長に応じて特定の位置に分配させる機能(逆多重化)は、WDM(Wavelength Division Multiplexing)を基盤とする光システムでは必須である。

【 0 0 0 3 】

このような機能は、現在までいろいろの方法または構造によって素子に実現されたが、 代表的なものとして、プリズムの屈折を利用した構造、回折格子(grating)また は集積型凹回折格子(integrated concave grating)を用い た構造、配列導波路回折格子(arrayed waveguide grating) を用いた構造を挙げることができる。

【0004】

このような構造の中でも、集積型凹回折格子と配列導波路回折格子を用いた構造は、シリカ(Silica)、GaAs、InP、LiTaO₃、ポリマー(Polymer) などの物質基盤に光導波路の形で製作することができ、集積が容易で素子性能が優秀であ って多用されている。その簡略な構造は図1に示した。

[0005]

次に、図1を参照して従来の凹回折格子を用いた逆多重化器を説明する。図1は従来の 凹回折格子を用いた逆多重化器の概略構成図である。

【0006】

図1では逆多重化器について示したが、2つの素子とも入射ビームと出射ビーム間の相 50

30

20

互作用によって多重化器としても使用可能である。よって、説明の重複を回避するために 逆多重化器についてのみ説明する。

【0007】

図1は上述した逆多重化機能を持つ導波路型凹回折格子構造を示している。前記構造に おいて、入力導波路に広帯域の光信号を含むビームを入射させると、ビームは入力導波路 10を介してA地点で回折格子30へ伝播される。前記伝播ビームは、回折格子30で波 長別に回折して分配され、分配されたビームは、図1のように各出力導波路20に波長別 に集束される。この際、分配されたビームは常時任意の軌跡上に位置するが、この軌跡を ローランド円(Rowland circle)という。前記凹回折格子の半径Rはロー ランド円の直径になる。凹回折格子とローランド円とが出会う点をポール(pole)と いう。

[0008]

前記従来の構造についての詳細な構造および適用は、特許文献1と特許文献2に詳細に 開示されている。

【 0 0 0 9 】

次に、従来の技術による波長可変逆多重化器を説明する。凹回折格子を波長可変逆多重 化器として使用する場合、多数の入力導波路を製作してその中の一つのみに、広帯域の光 信号を含むビームを入射させる構造を挙げることができる。この場合、入射ビームはロー ランド円上に位置し、入射ビームの入射角を変化させて回折格子の公式に基づいて波長を 可変させる構造である。簡単な例として、前記構造においてある導波路を介してビームを 入射させて各出力導波路に 1~ nのビームが出射された場合、他の導波路を介してビ ームを入射させると、出力導波路に出射される波長はそれぞれ '1~ 'n に変わる

20

30

40

10

[0010]

この構造は、選択的に入射ビームの位置を調整させて波長を可変させる方式なので、多数の入力導波路が必要であり、波長可変特性が離散的(discrete)で波長可変量に制限があるという問題点をもっている。

[0011]

別の構造によれば、入力導波路の代わりに光ファイバにビームを入射させ、光ファイバ の位置を移動させて波長可変逆多重化器として動作させる方式がある。この構造は、特許 文献3に詳細に開示されているもので、光ファイバの位置を連続的に移動させることがで きるので、連続的な(continuous)波長可変特性をもつが、光ファイバの空間 的移動により構造的に不安定であり、波長可変のための速度が遅いという欠点をもってい る。

[0012]

一方、配列導波路回折格子構造を波長可変逆多重化器として活用することもできる。す なわち、多数の入力導波路を利用する構造である。この構造の一点から他の点へ放射ビー ムの位置を移動すると、入力結合器内の入力口径に結合するビームの位相が変化して出力 導波路に出射されるビームの波長が変化する。このような配列導波路回折格子の構造を用 いる構造は、凹型回折格子構造と原理上同様なので、波長可変特性が離散的であるという 問題により、連続的な波長可変を有する逆多重化器に適用することが難しい。

【0013】

したがって、前記従来の波長可変逆多重化器および多重化器の多数の入力導波路を利用 する構造は波長可変特性が離散的であって有用ではなく、光ファイバを移動させる構造は 光ファイバの移動により構造的に不安定であり、波長可変のための速度も遅いという問題 点を抱えている。

【0014】

次に、波長可変レーザについて説明する。

最近、電子商取引、 V O D 、画像会議といった新しいマルチメディアの出現とH D T V 、 L A N 、 C A T V などといった従来のデータ通信の発達に伴い、情報容量が急増してい 50 る。超高速情報通信網事業者は、莫大なコストと時間がかかる新規の光ファイバを設置す る代わりに、既存の光ファイバの帯域幅を極大化するWDM(Wavelength D ivision Multiplexing)伝送方式を使用することにより、伝送効率 を極大化する方式を採用している

[0015**]**

上述した光伝送方式の使用に伴って、様々な機能を有する光素子が必要となり、特に波 長可変半導体レーザ(tunable wavelength semiconduct or laser)は前記通信網で最も応用範囲の広い光源として脚光を浴びている。 【0016】

波長可変レーザは、WDM伝送方式の以前には主に光計測装備用として用いられたが、 その以後には波長固定半導体レーザ(fixed wavelength semico nductor laser)の代替用または緊急なバックアップ用として活用されてお り、ROADM(Reconfigurable Optical Add/drop multiplexer)の光源として緊急に求められている。さらに、電光通信網(A ll optical network)のパケットスイッチ(packet swit ch)、波長変換器(wavelength conversion)、波長ルータ(W avelength router)など非常に様々な領域にまで拡大しつつある。 【0017】

波長可変半導体レーザは、現在まで多くの種類が提案されたが、その中でも特に分布ブ ラグ反射器型レーザダイオード(distributed Bragg reflect 20 or laser diode)と外部共振器型レーザダイオード(external cavity laser diode、以下「ECLD」という)が主に活用されてい る。ECLD構造は、本発明の構造との比較のために詳細に説明する。

【0018】

ECLDは、半導体レーザと外部回折格子(external diffractio
n grating)から構成されており、回折格子の空間的変異(回転、移動)により
回折条件(diffraction condition)を変化させて連続的な波長可
変特性を得ることができる。上述したECLDは、高い光出力(high output
power)、狭い線幅(narrow linewidth)、広い波長可変特性(
wide tenability)により従来の計測装備に多く活用されているが、半導体レーザと回折格子間の位置合わせの難しさ、波長可変時の回折格子の空間的移動による

機械的振動、ピボットポイント(Pivot point)位置のエージング(agin g)による波長移動(wavelength shift)が問題となり、特に波長可変

のための速度が非常に遅いため、光通信システムへの活用には多少無理がある。

30

10

[0019]

上述した E C L D 構造において素子の低い信頼性および遅い波長可変速度を解決するために、電気的な調節により波長を可変させる構造が提案された。

【0020】

【0021】

特許文献1(発明の名称:電気信号によって動作する光偏向器およびこれを用いた波長 可変型外部共振器)では、半導体レーザダイオード(又は光増幅器)、レンズ、回折格子 、反射鏡から構成されているリトマン型外部共振構造の波長可変レーザを提案した。前記 構造において、回折格子と反射鏡との間にビームの方向を偏向させる偏向器が介在されて おり、電流注入により偏向器内媒質の屈折率を変化させ、回折格子から反射鏡へ入射する 角度を調節することにより、波長可変が行われる。 [0022]

非特許文献5では、半導体レーザダイオード内の偏向器がモノリシック集積されて偏向 器領域に電流注入による導波ビームの位置変化により回折格子への入射角が変わって波長 可変が行われる構造を提案した。上述したような偏向器の挿入または集積が行われた外部 共振器型波長可変レーザは、波長可変のための速度が速く、構造的に簡単であるという利 点があるが、回折格子とレーザダイオード間の整列が難しく、レンズおよび回折格子によ る素子の体積が大きいという欠点があった。

【0023】

すなわち、従来の波長可変レーザ構造のECLDは、レーザダイオードと外部回折格子、レンズ、反射鏡間の整列(alignment)が難しく、前記追加光学部品の挿入に ¹⁰より素子の体積が大きいという問題点がある。

【0024】

【特許文献1】韓国特許第444,176号明細書

【非特許文献1】"Monolithic integrated wavelengt h demultiplexer based on a waveguide Row land circle grown in InGaAsP/InP", IEEE Journal of Lightwave Technology, vol. 16 , no. 4, April 1998

【非特許文献2】"Theory and simulation of a conc ave diffraction grating demultiplexer fo 20 r coarse WDM systems", IEEE Journal of L ightwave Technology, vol. 20, no. 4, Apr il 2002

【非特許文献3】"Tunable planar concave grating demultiplexer", IEEE Photonic Technology Letter, vol.8, no.4, April 1996 【非特許文献4】M. Kourogiの外4名、"continuous tunin g of an electrically tunable external-ca vity semiconductor", Optics Lett., vol. 25, no. 16, pp.1165-1167, August 2000 【非特許文献5】O.K.Kwonの外6名の"proposal of electr ically tunable external-cavity laser dio de", IEEE Photon. Tech. Lett., vol.16, n o. 8, pp.1804-1806, August 2004

30

40

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0025】

そこで、本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、従来の逆 多重化器の製作収率の向上と波長可変フィルタ、ルータなどの様々なWDM用素子の活用 のために新しい類型の波長可変逆多重化器を提供することにある。

【0026】

本発明の他の目的は、波長可変特性が連続的であり、製作が容易であるうえ、構造的に 安定しており、波長可変のための速度が速い波長可変逆多重化器を提供することにある。 【0027】

本発明の別の目的は、波長可変特性が連続的で、製作が容易で、モノリシック集積構造 なので位置合わせが容易で、素子の大きさが小さく、構造的に安定しており、波長可変の ための速度が速い波長可変逆多重化器を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0028】

上記課題を解決するための技術的手段として、本発明の第1側面は、お互い異なる多数 50

の波長を有する多数の光が導波される入力導波路と、入力導波路を介して伝達された光を 、放射状に分散する光に偏向させる光偏向器であって、第1の有効屈折率を有する周辺領 域と、前記第1の有効屈折率とは異なる第2の有効屈折率を持つ所定形状の偏向パターン 領域とが境界を成して構成される光偏向器と、前記偏向された光を波長ごとに分離して反 射する回折格子と、前記回折格子を介して回折した光を選択して出力する出力導波路とを 含み、前記放射状に分散する光は、第2の有効屈折率に応じて変わる所定の軌跡上の特定 点から出発して進む、波長可変逆多重化器を提供する。

(6)

[0029]

好ましくは、所定形状の偏向パターンと周辺領域は、上部クラッド層のドーピング構造 の差により境界を成して構成されるが、外部電気信号(電流または電圧)に対して、偏向 パターン領域内のみに電気信号が印加されて有効屈折率が変化する構造を提供する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

本発明を実際に実現する場合においては、前記光偏向器は、下部クラッド層、上部クラ ッド層およびコア層を有する光導波路で実現でき、前記偏向パターン領域の内部と周辺領 域のコア層媒質が同一となるよう、かつ上層部クラッド層のドーピング差のみが異なるよ うに構成することができる。この場合、偏向パターン内の電気信号を印加(または電流注 入)しなければ、屈折率は同一となり、電流注入または電圧印加を行えば、偏向パターン 内のコア層のみに電流注入(または電圧印加)が行われるので、偏向パターン内の屈折率 が変わる。

[0031]

本発明の第2側面は、お互い異なる波長の光が導波される入力導波路と、前記入力導波 路を介して伝達された光を、放射状に分散する光に偏向させる光偏向器を含み、前記光偏 向器は第1の有効屈折率を有する周辺領域と、前記第1の有効屈折率とは異なる第2の有 効屈折率を持つ所定形状の偏向パターン領域とが境界を成して構成される入力結合器と、 前記入力結合器を介して伝達された光が通過する導波路と、前記導波路から出力された光 が結合する出力結合器とを含むが、前記放射状に分散する光は、前記第2の有効屈折率に 応じて変わる所定の軌跡上の特定点から出発して進む、波長可変逆多重化器を提供する。 [0032]

本発明の第3側面は、第1断面および第2断面を備える光増幅器と、前記光増幅器に集 積され、前記第1断面から放射されて出射されるビームを凹回折格子に伝達し、凹回折格 子から反射されたビームを前記第2断面に受ける前記光増幅器および前記回折格子との間 に位置する光偏向器であって、第1有効屈折率を有する周辺領域と、前記第1有効屈折率 とは異なる第2有効屈折率を有する所定の形状の偏向パターン領域とが境界をなす光偏向 器と、前記光偏向器に連結され、前記光偏向から入射したビームの中でも特定の波長のみ を前記光増幅器に帰還させる回折格子とを備えるが、前記回折格子から反射された分散光 は、第2有効屈折率に応じて変わる所定の軌跡上の特定点から出発して進む、波長可変レ ーザを提供する。

【発明の効果】

[0033]

上述したように、本発明は、従来の逆多重化器の製作収率の向上、および波長可変フィ ルタ、ルータなどの様々なWDM用素子の活用のために、新しい類型の波長可変逆多重化 器を提供する。

[0034]

また、本発明は、波長可変特性が連続的であり、製作が容易であるうえ、構造的に安定 しており、波長可変のための速度が速い波長可変逆多重化器を提供する。

【発明を実施するための最良の形態】

[0035]

以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施例を詳細に説明する。ところが、こ れらの実施例は様々な形に変形できるが、本発明の範囲を限定するものではない。これら の実施例は当該技術分野で通常の知識を有する者に発明を十分理解させるために提供され

10

20

30

るものである。下記の説明において、ある層が他の層に在ると記載されるとき、これは他 の層の真上に存在することもあれば、またはその間に第3の層が介在されることもある。 また、図面における各層の厚さまたは大きさは説明の便宜および明確性のために誇張され た。

【0036】

(第1 実施例の波長可変逆多重化器)

次に、図2を参照して本発明の第1実施例に係る波長可変逆多重化器を詳細に説明する。図2は本発明の第1実施例に係る波長可変逆多重化器の構成図である。

【0037】

波長可変逆多重化器100は、お互い異なる波長の光が導波される入力導波路110と 10 、入力導波路110を介して伝達された光を、放射状に分散する光に偏向させる光偏向器 140と、偏向された光を波長別に分離して回折させる回折格子130と、回折格子13 0を介して回折した光を選択して出力する出力導波路120とを含む。

【0038】

光偏向器140は、分散する光を偏向させ、格子極(grating pole)に入 射する入射角を から 'に変える。したがって、回折格子130の公式に基づいて出力 導波路120へ回折するビームの波長が ₁、 ₂、 ₃、 ₄から '₁、 '₂、

'₃、 '₄に変わる。

【0039】

一方、偏向ビームの光源がローランド円(Rowland circle)に沿って動 ²⁰ くように設計されており、偏向ビームの光源の位置は連続的にローランド円に沿って仮想 的に移動する。

【0040】

以下、図2記載の光偏向器140を図3a~図3cを参照して詳細に説明する。図3a を参照すると、光偏向器140は、第1の有効屈折率n₁を有する周辺領域141と、他 の有効屈折率である第2の有効屈折率n₂を持つことにより、境界f(x)を形成する所 定の形状の偏向パターン領域142とからなる。このような光偏向器140によれば、入 力導波路110を介して入力された光が放射されるとき、所定の偏向パターンの境界f(x)によって特定の一点(a、b)から出発して進む方向に偏向させられる。一方、第2 の有効屈折率n₂の変化によって特定の一点(a、b)の位置は変化する。すなわち、第 2の有効屈折率の変化に応じて偏向パターン領域142を通過した光の仮想光源(a、b)は、限定された区間内に直線や円などの任意の軌跡で示すことができる。したがって、 放射状に進む光がローランド円上の特定点から出発して進むように構成することにより、 本実施例に係る波長可変逆多重化器を実現することができる。

【0041】

各領域における「有効屈折率」は、媒質の屈折率ではなく、導波路の有効屈折率である 。有効屈折率は、媒質屈折率とは異なって導波路の固有モード(eigen-mode) であり、導波路の幅、コア層の厚さ、コア層の屈折率が変化すると、有効屈折率も変化す る。参考として、入力導波路110の有効屈折率と入力導波路の外側部分の有効屈折率は 、積層されている物質が同一であっても導波路の厚さが異なるため、お互い異なる可能性 がある。

【0042】

所定形状の偏向パターン領域142の境界を形成する軌跡y=f(x)は、次のような線-光(ray-optics)に基づいた方法によって求めることができる。y=f(x)軌跡のx切片をqとし、任意の放射光y=mx(m=tan(___))とy=f(x)との交差点でy=f(x)軌跡の接線は傾きがt(=tan(-___t))であると仮定する。ここで、放射光と軌跡の接線に垂直な法線との角を _1(入射角)とするとき、数式1が成立する。
【0043】

(7)

10

20

30

40

【数1】

$$-\theta_t = \frac{\pi}{2} - \theta_2 - \theta_m$$

[0044]

ここで、接線の傾きtは負の値を有するので、 _tは正の角で示すスカラーであるから、数式1が得られた。一方、前記数式1の両辺にtanを取り、左辺をまとめると、数式2で表わされる。

【0045】

【数2】

$$\tan(-\theta_t) = \frac{m\tan(\theta_2) - 1}{m + \tan(\theta_2)} = t = y'$$

【0046】

ここで、m(=y/x)とtan(₂)はx、yの変数であり、tan(- _t)は 軌跡y=f(x)の接線の傾きtを示すので、yの1次微分(y')であり、結局xに対 する1次微分方程式で表わされる。一方、図3aにおいて、 ₁は偏向光の屈折角を示し 、偏向光(点線)は仮想円点(a、b)を通ると仮定すると、数式3のように表現するこ とができる。

【0047】

【数 3 】

$$y = \tan(\theta_m - (\theta_1 - \theta_2))(x - a) + b$$

【0048】

ここで、 ₁と ₂はスネルの法則(n₁sin ₁=n₂sin ₂)を満足し、 ₁を ₂で表現してまとめると、数式4で表わされる。 【0049】 【数4】

$$\begin{bmatrix} Bn_2 + \sqrt{(n_1^2 - n_2^2)} + (n_1/\tan(\theta_2))^2 \end{bmatrix} \tan(\theta_2) - \begin{bmatrix} n_2 - B\sqrt{(n_1^2 - n_2^2)} + (n_1/\tan(\theta_2))^2 \end{bmatrix} = 0$$

$$B = \frac{m(x-a) - (y-b)}{m(y-b) + (x-a)}$$

[0050]

軌跡 f (x) は数式 4 で得られる t a n ($_2$)を数式 2 に代入し、初期値(q、0) の微分方程式を解けば得ることができる。上述した f (x)を求める方法に対し、数式 4 の t a n ($_1$) は平方根 (s q u a r e r o o t)の内と外にあるので、直接 (s t r a i g h t - f o r w a r d)解くことが難しく、数式 2 の微分方程式の一般解は x と y が結合しているので、アナリティック解 (a n a l y t i c s o l u t i o n)で表 現することが難しい。したがって、数式 4 は t a n ($_2$) に対して s e l f - c o n s i s t e n t 方法を用いて数値的 (n u m e r i c a l)に解き、数式 2 は R u n g e -K u t t a 法を用いて軌跡を得た。数値解析の具体的な方法は、当業者に一般に知られて いる方式を使用する。

【0051】

一方、半導体光導波路構造では、注入電流により、有料屈折率は増減できる。これは入 射光の波長に対するコア層のバンドギャップエネルギーに依存するが、一般に入射光の波 長エネルギーに比べてコア層のバンドギャップエネルギーが大きくなるようにコア層の物 質組成を使用すると、電流注入によって有効屈折率が減少する。このように使用する理由 は、コア層のバンドギャップエネルギーが入射光の波長エネルギーに比べて大きければ大 きいほど光損失が少なくなるためである。しかし、光損失が少なくなるほど屈折率の変化

も少なくなるので、屈折率の変化量を考慮して適切に設計することが好ましい。 【0052】

したがって、本発明における図3 a の軌跡を求めるための数学的モデルは、 n₁ > n₂ の場合について示したが、前記条件と逆に n₁ < n₂の場合には軌跡の形態が変わる可能 性がある。ところが、解析過程は同一である。

【0053】

ー方、上述した数学的モデルにおいて放射光と軌跡との交点での接線の傾き t が陰数の 場合についてのみ示したが、陽数の場合にも成立する。この場合、 t に対する m と 1 の関係変化(数式1、2の変化)により軌跡の形態は変わる可能性がある。上述した説 明に対する y = f (x)の大略的な形態は図3bに示した。

【0054】

また、図3aの解析モデルは、光が左から右に放射する場合についてのみ示したが、右から左に放射する場合についても、軌跡はその形態が異なり、 y軸に対して対称構造であることを予測することができる。

【0055】

一方、図3cは上述した光偏向器の変形例を説明するための概念図である。図3cを参照すると、この偏向器は、偏向パターン領域142と入力導波路110との間に放射型進行光を生成するために、第3有効屈折率を有する円形パターン領域143をさらに含む。 この円形パターン領域143は、原点0から放射する光が、有効屈折率がn₃とn₂の境界を有する半円(x² + y² = r²、x>0)を通過するとき、放射光と円の接線は常に垂直なので、入射角が0となって屈折が発生しない。一方、この円形パターン領域143の第3有効屈折率は第1の屈折率と同様に実現することもできる。円形パターン領域14 3によって放射される光は、有効屈折率n₃とn₂の境界を有する半径rの円を通過し、この境界を通過するときには屈折現象が起こらない。通過した光はさらに軌跡f(x)を示す境界を通過しながら屈折する。この際、屈折した光は常に仮想原点(a、b)を通過する。

[0056]

すなわち、図3 c の光偏向器を図3 a の光偏向器と比較すると、図3 c の光偏向器の場合は、放射光を形成する目安となる原点が偏向パターン領域1 4 3 の外部に形成されている。図2 はこの場合を例として示している。図3 a の光偏向器の場合は、放射光を形成する目安となる原点が偏向パターン領域1 4 3 の内部または境界線に形成されることにより、図3 c の光偏向器の円形パターン領域1 4 3 が追加されなくてもよい。

30

40

20

10

【 0 0 5 7 】

ローランド上に沿う線 - 光の立場から光偏向器の一例が説明されたが、逆に、波 - 光の 立場から一般化されることもできる。したがって、格子の構造に応じて偏向器パターンの 模様と個数が変更できる。

[0058]

図3dは本発明の光偏向器の具体例を示した断面図である。図3dは図3cのA-A' に沿った断面図である。図3dはInP系列の物質を用いて実現した一例である。

【0059】

図3dを参照すると、大きくn-金属層1100、p-金属型1170、上部クラッド層1130、1140、コア層1120、下部クラッド層1110から構成することができる。識別番号1150は絶縁層を示している。

[0060]

n - 金属層1100は例えばCr - Au層からなり、p - 金属層1170は電気伝導度 の向上を目的としてTi - Pt - Au層を構成することができる。InGaAs金属コネ クタ層1180は、p - 金属層1170と上部クラッド層1130、1140間の円滑な 電気伝導のために高濃度でpドーピングが行われている。InPの上部クラッド層113 0、1140は、図3dに示すように、nとpに分離されてドープされており、pドープ トInPとnドープトInP間の境界は図3cの偏向パターンの境界である。InP(第

(9)

3~5族)へのpまたはnドーピングのために、例えば第4族(Si、Ge)または第6 族の元素をソースとして用いる。

【0061】

この構造において、ドーピングに関係なくクラッド層1110、1130、1140の 媒質屈折率は、入射光が1.55µmで全て約3.17である。InGaAsPコア層1 120は、ドープされておらず、GaとAsの組成追加によりクラッド層1110、11 30、1140に比べて媒質の屈折率が相対的に高いため、光はInGaAsPコア層1 120に導波される。

[0062]

この構造で電流が注入されていない場合には、導波路の有効屈折率は特定値を持つ。こ 10 こでは、有効屈折率をn₁と仮定する。これに対し、電流が注入される場合、一般的なp - n 接合(junction)の順方向バイアス(forward bias)に該当するので、電 流は、p-金属層1170、金属コンタクト層1180、上部クラッド層1130、11 40、InGaAsPコア層1120、下部クラッド層1110、n-金属層1100へ 流れる。

[0063]

ここで、上部クラッド層1130、1140内に注入された電流は、 pドープトInP とnドープトInP間の電位障壁(potential barrier)により、偏向 器パターン内のpドープトInPのみへ流れる。このような構造により、電流は偏向器の パターン内のみに注入され、コア層内の偏向器パターンの媒質屈折率は変わる。したがっ て、コア層の媒質屈折率の変化により、偏向器パターン内の有効屈折率はn₁からn₂に 変わる。

[0064]

上述した構造では、偏向器パターンを上部クラッド層に形成する代わりに、電極または 金属コンタクト層を偏向器パターンで形成する構造が使用できる。ところが、電極または 金属コンタクト層を偏向器パターンで形成する場合、電流は上部クラッド層において拡散 特性により広がってしまうため、活性層に到達する電流のパターンは偏向器のパターンと は異なるため、図3dの構造に比べて効果的でない可能性がある。一方、図3dの構造は 、電極または金属コンタクト層で、偏向器パターンとは関係なくコア層の直上の上部クラ ッド層に偏向器パターンが形成されており、パターン内のみに電流が流れてコア層に注入 されるので、安定した光偏向特性を得ることができる。 【0065】

30

40

20

一方、入射光の波長が1.55µmの場合、InGaAsP物質において、電流注入により、一般に媒質の屈折率は最大約0.05程度減少する。ところが、InP/InGaAsP物質において、入射光の波長が異なる場合、あるいはInP/InGaAsP物質の他に半導体の光素子に使用される他の物質(GaAs/AlGaAsやGaAs/InGaAsなど)では、電流注入による屈折率の変化量が異なり、電流注入による屈折率の変化の他に電圧または電気光学(Electro-optic)、音響光学(Accosto-optic)効果によって屈折率が増加または減少する。

[0066]

図4は本発明の構造波長可変逆多重化器における回折格子の構造一例を示す図である。 前記格子は、chirped grating、balzed grating、TIR(Total Internal Reflection)grating、sinuso idal gratingなど様々に実現できる。

[0067]

図4を参照すると、本回折格子は、CC'線分で周期dを持つ格子構造であり、N番目の回折格子に入射して反射されるビームとN+1番目の回折格子に入射して反射されるビームとの位相差は、回折次数mに対して2mPを満足しなければならない。図2の点Aからポール(Pole)地点を結んだ直線と×軸間の内抱角 は、回折格子130の入射角になり、回折格子130における入射角に対する回折特性は数式5の回折格子公式に従う

【0068】 【数5】 $m\lambda = nd(\sin\alpha + \sin\beta)$

【0069】

ここで、 は波長、nは媒質の屈折率、 は入射角、 はm次の回折角をそれぞれ示す

(11)

【0070】

一方、上述した光偏向器140を介して偏向されたビームは、回折格子130の入射角 10 を変え、数式1の回折格子130の公式に基づいて出力導波路120へ回折するビームの 波長が変わる。

【0071】

(第2実施例の波長可変逆多重化器)

以下、図5を参照して本発明の第2実施例に係る波長可変逆多重化器について説明する。図5は本発明の第2実施例に係る配列導波路回折格子の構造を用いた波長可変逆多重化 器の構造図である。

【0072】

第2実施例の波長可変逆多重化器は、広帯域の光信号を含む光が分離されて導波される 入力導波路210と、入力導波路210を介して伝達された光を、放射状に分散する光に 偏向させる光偏向器240とを含む。光偏向器240は、第1の有効屈折率を有する周辺 領域と、第1の有効屈折率とは異なる第2の有効屈折率を有する所定形状の偏向パターン 領域とが境界を成して構成される入力結合器250と、入力結合器250を介して伝達さ れた光が通過する円形導波路270と、円形導波路270を介して出力された光が結合す る出力結合器260とを含む。この構造において、第2の有効屈折率の変化により、放射 状に分散する光はローランド円上の特定点から出発して進む。

【0073】

この構造において、入力導波路210からビームが放射されて入力結合器250の入力 口径でビームが結合し、出力結合器260の出力口径からビームが放射されて出力導波路 220の各端子にビームが結合する。このような結合構造において、入力導波路210と 出力導波路220は上述した凹回折格子と同様にローランド円上に位置し、ローランド円 の直径Rは入力導波路210と出力導波路220との焦点距離(focal lengt h)になる。

[0074]

逆多重化がなされるためには、円形導波路270における各導波路の長さが、隣接した 円形導波路と補強干渉するように設計されるべきである。ここで、円形導波路270は、 凹回折格子で回折格子と同一の役割をしているため、前記構造を配列導波路回折格子(a rrayed waveguide grating)とも呼び、位相器(phaser)とも呼ぶ。

【0075】

このような構造で入力結合器250内に形成されている偏向パターンに電気信号を印加 すると、放射ビームは偏向し、入力導波路210の位置はローランド円に沿って仮想的に 移動する。この際、光偏向器240による入力導波路210の仮想的位置変化は、入力結 合器250内の入力口径で結合したビームの位相差を変化させ、出力導波路220に結像 するビームの波長を変える。電気信号により偏向されたビームは、入力結合器250内の 入力口径に結合するビームの位相が変わって出力導波路220に結像するビームの波長が 変わる。

[0076]

(第3実施例の波長可変レーザ)

以下、図6を参照して本発明の第3実施例に係る波長可変レーザを説明する。図6は第 50

30

40

10

30

3 実施例に係る波長可変レーザの概略構成図である。

【0077】

波長可変レーザは、光増幅器(optical amplifier)510、光偏向 器(optical deflector)530、凹回折格子(concave gr ating)520がモノリシック集積されているモノリシック集積外部共振型波長可変 レーザである。

【0078】

光増幅器510の一側端面から出力されるビームは、光偏向器530を経て凹回折格子 520に入射する。入射したビームは回折格子520から特定の波長のみが光増幅器51 0に帰還する。この構造において、光増幅器の他側端面と凹回折格子はそれぞれ反射面を 有するので、共振器から形成されてレーザダイオードとして動作する。

【0079】

光偏向器530は、第1の有効屈折率n₁を有する周辺領域と、第1の有効屈折率n₁ とは異なる第2の有効屈折率n₂を有する所定形状の偏向パターン領域とが境界を成して 構成され、外部電気信号によって所定形状の偏向パターンの有効屈折率を変化させて周辺 領域と所定形状の偏向パターン領域間の境界面における入射角に対する屈折特性(スネル の法則)に応じてビームが偏向させられる特性をもっている。

【0080】

図6において、光偏向器530は、偏向器内の電気信号増加に伴って光増幅器510か ら放射するビームの点光源(point source)の位置がローランド円に沿って ²⁰ 仮想的に動くように設計される。光偏向器530については第1実施例で詳細に説明して いる。一方、光偏向器530を介して屈折したビームは、前記図面の赤色点線のように等 価的に表示され、入射角がaからa'に変わる。

【0081】

前記入射角の変化に応じて、数式6のリトロー(Littrow)回折格子公式に基づ いて回折するビームの波長が変わる。

【0082】

【数6】

 $m\lambda = 2n_1d\sin\alpha$

【0083】

ここで、mは回折格子、 は波長、n₁は導波層の屈折率、dは回折格子の周期をそれ ぞれ示す。

[0084]

第1 実施例と比較すると、第1 実施例では入力導波路の近くに光偏向器が集積されて入 射ビームを屈折させることにより、出力導波路に結合する波長を可変させる構造であり、 この構造において、波長可変特性はリトマン(Littman)回折公式に従う。

【0085】

前記構造は、数式6のリトロー(Littrow)条件によって実現したが、下記数式 7のリトマン条件による他の構造にも適用することができる。この場合、図8に示すよう 40 に、導波路または光増幅器が付加されるべきである。図8において、光増幅器601およ び602の左側面が反射面になり、前記2つの反射面に共振が発生する。

[0086]

【数7】

 $m\lambda = n_1(\sin\alpha + \sin\beta)$

【0087】

図 7 a および図 7 b は第 3 実施例に係る波長可変レーザの可変特性を詳細に説明するための図である。

【 0 0 8 8 】

図9aおよび図9bは本発明の第4実施例に係る波長可変レーザの可変特性を説明する ための図である。

[0089]

図7aを参照すると、光偏向器530内に電気信号が印加されていない場合のビーム特 性を示しており、光増幅器510で光利得が生成されたビームは、 1の波長で光偏向器 520を通過し、光偏向器530のパターンの有効屈折率と周辺領域の有効屈折率とが同 ーなので、ビーム屈折率は現れなくなる。凹回折格子520に入射したビームは、数式6 に基づき、入射角 に応じて特定の波長(1)のみが光増幅器510に帰還する。光増 幅器510に帰還した 」波長のビームは、光増幅器510の内部で注入ロック(ini ection locking)されると同時に共振(resonant)され、光増幅 器510の左側端面に出射される。

[0090]

図7bを参照すると、光偏向器パターン530に電気信号が印加されてパターン内の導 波層の屈折率がn₁からn₂に変化した場合のビーム特性を示している。光増幅器から生 成されたビームは偏向器パターンを通過し、偏向器内のコア層の屈折率の変化に応じて屈 折する。前記屈折したビームの光源は添付図面のように仮想的にローランド円を通過し、 屈折したビームの入射角はa角から等価的にa)角に変わる。前記変化した入射角により 、数式1に基づいて回折ビームの波長は ₁から ゥに変わる。

[0091]

20 前記光偏向器パターンの模様はローランド円の構造に合うように線 - 光の観点によって 設計されたが、偏向器パターンは格子の構造に応じて変形できる。光偏向器の構造および 波長可変レーザの可変特性は、図10に示すように一般化できる。

[0092]

図10は偏向器パターンの概略図である。格子に伝播されるビームを考慮しなければ、 偏向パターンの大きさは偏向器dの数の増加に応じて拡張できるように設計される。各パ ターンは、ビームの光経路によって2つのインターフェースを有し、パターンの一側は導 波路と垂直になるように設計される。他のインターフェースの曲線を決定するために、格 子によって回折した後、導波路に焦点が集められた光を考慮しなければならない。ここで 、 2 つの隣接する格子要素間の位相差は、照射波長 に対する 2 の倍数と同一でなけれ ばならない。 P_N(N番目の要素)および P₀(極)点に集中した格子面に反射された光 間のN番目の位相差 Nは、下記数式8で表現される。

30

10

[0093] 【数8】

$$\begin{split} \Delta \Phi_N &= \Phi_{\overline{AP_0}} - \Phi_{\overline{AP_0}} \\ &= \frac{4\pi}{\lambda} \left(n_0 L_N - (n_0 - n_D) \sum_{a=1}^d l_{Na} \right) - \frac{4\pi}{\lambda} \left(n_0 L_0 - (n_0 - n_D) \sum_{a=1}^d l_{0a} \right) \\ &= 2\pi m N \end{split}$$

40

[0094]

ここで、n_Dおよびn₀は、偏向パターンの内側と外側の有効反射率である。mは格子 順番、Nは極点からの格子要素の数である。前記数式8より、波長可変 は下記数式9 のように得ることができる。

[0095]

【数9】

$$\Delta \lambda = -\frac{2}{mN} \sum_{a=1}^{d} (l_{0a} - l_{Na}) \Delta n_{D}$$

[0096]

ここで、 N_Dは、光拘束要素に強く依存する格子パターンにおける有効屈折率の変化 および導波コア物質の屈折率の変化である。与えられたmに対し、1_{01~d}および n _{DE}、インターフェースの曲線は に対する1N_{1~d}の軌跡から得ることができる。 ところが、格子パターンが2つ以上の場合、数えられない1N_{1~d}の組み合わせがあり うる。よって、各格子パターン aに対する波長可変は、下記数式10のように定義で きる。

【0097】

【数10】

$$\Delta \lambda_a = -\frac{2}{mN} (l_{0a} - l_{Na}) \Delta n_D$$

10

【0098】

ここで、 aの和は となる。偏向パターンへの電流の注入により、屈折率におい てキャリア - 誘導(carrier - induced)変化 n_Dは減少する。 【0099】

前記従来の波長可変逆多重化器の構造は、多数の入力導波路を備えるか、あるいは入力 導波路の代わりに光ファイバを移動させて波長可変特性を実現したが、波長可変特性がそ れぞれ離散的であり、波長可変のための速度が遅いという欠点を持っている。本発明の構 造は、波長可変特性が連続的であり、波長可変のための速度が速く、電気的に波長可変を させるので構造的に安定している。前述した本発明の構造は、従来の逆多重化器の製作の 際に発生する工程上の誤差を補正して製作収率を高めると同時に、波長可変フィルタまた はルーターとして活用することができるので、活用価値は非常に高い。 【0100】

30

40

20

上述した本発明の波長可変逆多重化器は、連続的な波長可変特性により、従来の逆多重 化器の製作の際に発生する工程上の誤差を補正して製作収率を高めると同時に、波長可変 フィルタまたはルータとして活用することができるので、活用価値は非常に高い。 【0101】

また、本発明の構造は、電気的に波長可変させるので、構造的に安定的であり、波長可 変のための速度が非常に速い特徴をもっている。

【0102】

本発明の波長可変レーザを用いると、光偏向器内の電気信号印加量に応じて凹回折格子 への入射角が連続的に変わるため、波長可変特性が連続的であり、光増幅器(SOA)、 光偏向器、凹回折格子が単一基板上に製作できるため、追加的な整列が必要なく、従来の ECLD構造に比べて素子の大きさが非常に小さい。

【0103】

一方、位相制御部は、光増幅器と光偏向器との間に介在できる。前記位相制御部は、格子から光増幅器に入射するビームと、光増幅器から放出されたビーム間の位相を整合(matching)させる役割を行う。したがって、装置が特定波長を照射するにつれて、波長は位相条件の変動によるチャネルPC電流(I_{Pc})によって微細に調整される。 【0104】

また、図11に示した構造は、広い可変波長領域を獲得することが可能な構造に拡張で きる。図11には、例えば8-チャネル構造が示されている。電流I_{SOA}をSOAチャ ネルに注入するとき、光照射は格子からチャネルに向かう後光のリトロー(Littro w)条件に対応する波長で発生した。他のチャネルは、格子に対するそれぞれの位置によ って異なる波長で光が照射された。したがって、可変波長範囲は、チャネル数が増加する ほど倍加される(____(総可変波長範囲)=N(チャネル数)×____(個別波長範囲)、そして光合成器701と光増幅器702が出力ステージに挿入され、図12に示すよ うに一つのポートを介して出力を得ることができ、光増幅器702によって出力を向上さ せることができる。 **[**0 1 0 5 **]**

また、図11の構造は、リトロー(Littrow)構造に局限されるが、上述した構造の他にも、図13のように出力ステージに位相制御部801および光増幅器802が挿入された形のリトマン(Littman)構造に変形できる。

[0106]

以上、本発明の好適な実施例を挙げて詳細に説明したが、本発明は、これら実施例に限 定されるのではなく、本発明の技術的思想の範囲内で、当該分野で通常の知識を有する者 によって様々な変形が可能である。

【図面の簡単な説明】

[0107]

10

【図1】従来の凹回折格子を用いた逆多重化器の概略構成図である。

【図2】本発明の第1実施例に係る波長可変逆多重化器の構成図である。

【図3a】図2の光偏向器を説明するための図である。

【図3b】図2の光偏向器を説明するための図である。

【図3c】図2の光偏向器を説明するための図である。

【図3d】図2の光偏向器を説明するための図である。

【図4】本発明の構造波長可変逆多重化器における回折格子の構造一例を示す図である。

【図5】本発明の第2実施例に係る配列導波路回折格子構造を用いた波長可変逆多重化器の構造図である。

【図6】本発明の第3実施例に係る波長可変多重化器の概略構成図である。

20

【図7a】本発明の第3実施例に係る波長可変レーザの可変特性を説明するための構造である。

- 【図7b】本発明の第3実施例に係る波長可変レーザの可変特性を説明するための構造で ある。
- 【図8】導波路または光増幅器が付加された波長可変レーザの構造図である。

【図9a】本発明の第4実施例に係る波長可変レーザの可変特性を説明するために示す図である。

- 【図9b】本発明の第4実施例に係る波長可変レーザの可変特性を説明するために示す図 である。
- 【図10】DEパターンの概略図である。
- 【図11】8-チャネル構造を有する波長可変レーザの構成図である。
- 【図12】光結合器および光増幅器が挿入された波長可変レーザの構成図である。
- 【図13】位相制御部および光増幅器が挿入された波長可変レーザの構成図である。
- 【符号の説明】
- **[**0108**]**

100 波長可変逆多重化器

- 110 入力導波路
- 120 出力導波路
- 130 回折格子
- 140 光偏向器
- 141 周辺領域
- 142 偏向パターン領域
- 143 円形パターン領域
- 1100 n金属層
- 1110 下部クラッド層
- 1120 コア層
- 1130 上部クラッド層
- 1140 上部クラッド層
- 1170 p金属層
- 2 1 0 入力導波路

40

2	2	0	出力導波路
2	4	0	光偏向器
2	5	0	入力結合器
2	6	0	出力結合器
2	7	0	円形導波路
5	1	0	光増幅器
5	2	0	凹回折格子
5	3	0	光偏向器

【図1】

【図2】





【図3c】





【図3b】



【図 3 d】











【図6】



【図 7 a】



【図 7 b】









【図 9 b】













【図12】







フロントページの続き (74)復代理人 100142044 弁理士 渡邊 直幸 (72)発明者 クォン オウ キ 大韓民国 テジョン ユソング ソンガンドン(番地なし) ソンガン グリーン アパートメン F 317-1304 (72)発明者 キム カン ホ 大韓民国 テジョン ユソング ソンガンドン(番地なし) ソンガン グリーン アパートメン ▶ 306-102 (72)発明者 キム ジョン ホイ 大韓民国 テジョン ユソング ガンドン 458-7 ダックウォン ビラ 304 (72)発明者 キム ヒュン スー 大韓民国 テジョン ソグ ドゥンサン 2ドン 970 ヤンチョン アパートメント 112 - 803 (72)発明者 オウ クワァン リョン 大韓民国 テジョン ユソング シンスンドン 149-4 審査官 高 芳徳 (56)参考文献 特開平07-058392(JP,A) 特開平09-092933(JP,A) 特開2003-198056(JP,A) 特開平10-260326(JP,A) 米国特許出願公開第2003/0091265(US,A1) 特開平05-165070(JP,A) 特開平11-258435(JP,A) 特表平8-501187(JP,A) Oh Kee Kwon et al., IEEE Photonics Technology Letters, 2004年 8月, Vol.16, No.8, pp.1804-1806 Kang Ho Kim et al., Japanese Journal of Applied Physics, 2004年 4月15日, Vol.4 3, No.4B, pp.L543-L544 (58)調査した分野(Int.Cl., DB名) G 0 2 F 1/00 -7/00 5/50

H01S 3/00 - 5/50 G02B 6/12 - 6/43 JSTPlus(JDreamII) JST7580(JDreamII)